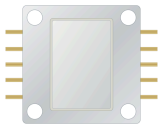
8000–12000 MHz GaN パッケージ型パワーアンプ — PSAT 46 dBm (標準値)

LCI-PA-8000-12000-PS46T · 8000–12000 MHz · GaN パッケージ型パワーアンプ.

RF 電気特性表の規定値: PSAT 46 dBm (標準値); 電力利得 24 dB (標準値); PAE 37 % (標準値). RF 測定条件: TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 22 dBm; PW = 100 µs; D = 10%.



FPC1515-10

ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。

Vg: C = 10 µF

Vg: 1, 5

RFin: 3

Vd: 6, 10

RFout: 8

NC: 2, 4, 7, 9

パッケージ外形寸法: 15.24 × 15.24 × 1.4 mm.

RF 特性

TA = +25 °C; VDS = 28 V; VGS ∈ [-3.2, -2.2] V; Pin = 22 dBm; PW = 100 µs; D = 10%

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
動作周波数	f	8000	-	12000	MHz
飽和出力電力	-	-	46	-	dBm
電力利得	-	-	24	-	dB
電力付加効率	-	-	37	-	%
電力利得平坦度	-	-	-	±0.5	dB

DC バイアスと電流

項目	記号	最小値	代表値	最大値	値	単位
ドレイン電圧	-	-	-	-	28	V
ゲート電圧	-	-	-	-	[-3.2, -2.2]	V

絶対限界値

限界値であり、通常動作の設定値ではありません。

項目	記号	最小値	代表値	最大値	単位
最大ドレイン・ソース間電圧	-	-	-	32	V
ゲート・バイアス下限	-	-5	-	-	V
保存温度	-	-65	-	150	°C
最大入力電力	-	-	-	27	dBm

パッケージ外形寸法

項目	値	単位
パッケージ外形寸法	15.24 × 15.24 × 1.4	mm

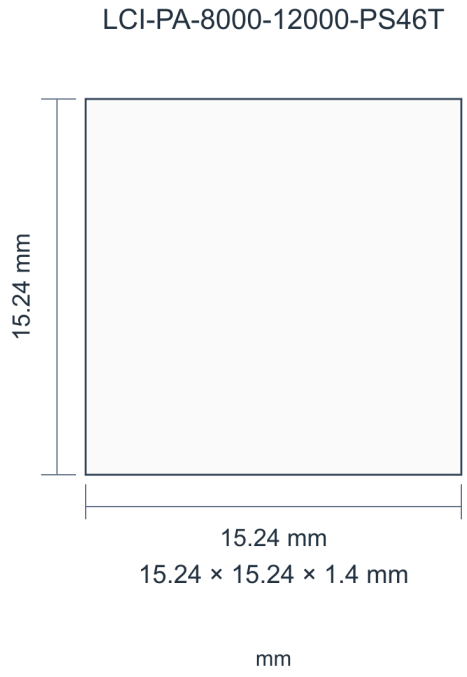
現在の発行記録 · 1.8 · 2026-11-12. 製品説明または編集内容を更新しました。 置き換え対象の改訂版 1.7.

実装上の注意

FPC1515-10 ゲート・バイアスを先に印加し、次にドレイン・バイアスを印加します。遮断時はドレイン側を先に除去します。 Vg: C = 10 µF Vg: 1, 5 RFin: 3 Vd: 6, 10 RFout: 8 NC: 2, 4, 7, 9

外形寸法図

確認済みの寸法を mm で示した部分図です。取り付けには、完全な取付図を参照してください。

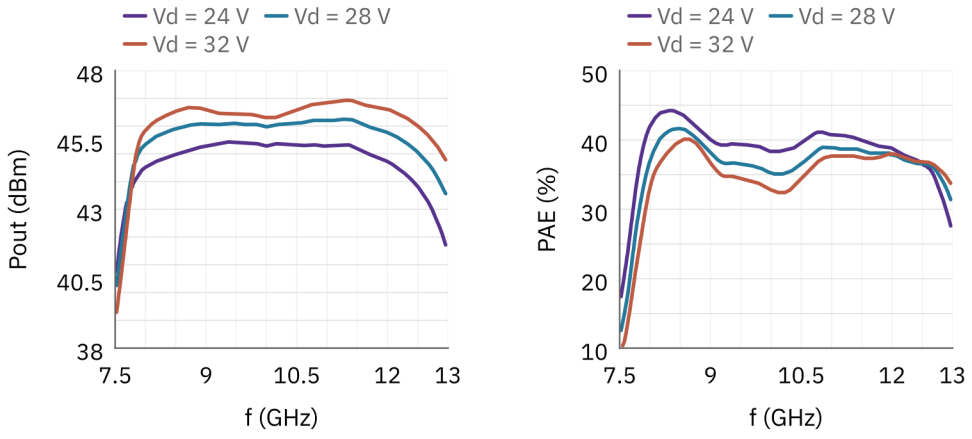


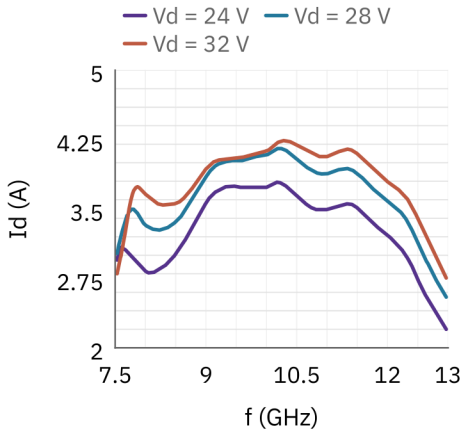
性能特性曲線

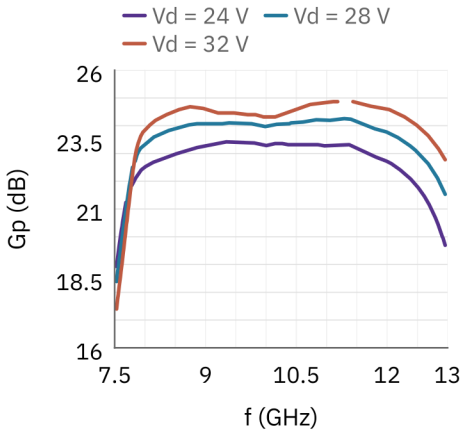
各性能グラフは、図中に示す動作条件における特性を表しています。

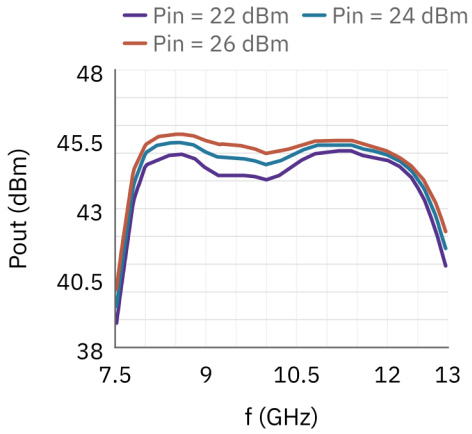
出力電力、電力付加効率、ドレイン電流、電力利得。

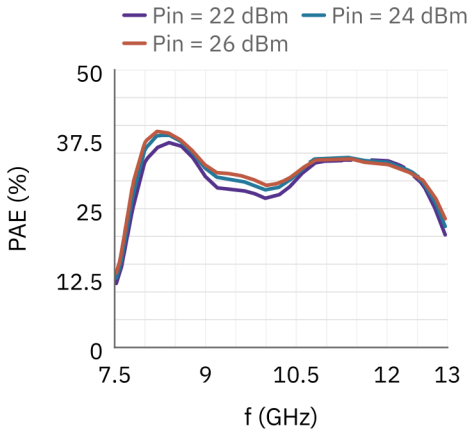
読み取り値は近似値です。 最初の4図はパルス条件です：PW = 100 µs、D = 10%、Pin = 22 dBm、Vg = −2.4 V、Temp = +25 °C、Vd = 凡例に従い 24/28/32 V。下段の Pout と PAE は CW 条件です：Vd = 28 V、Vg = −2.4 V、IDQ = 2.2 A、Temp = +25 °C、Pin = 凡例に従い 22/24/26 dBm。

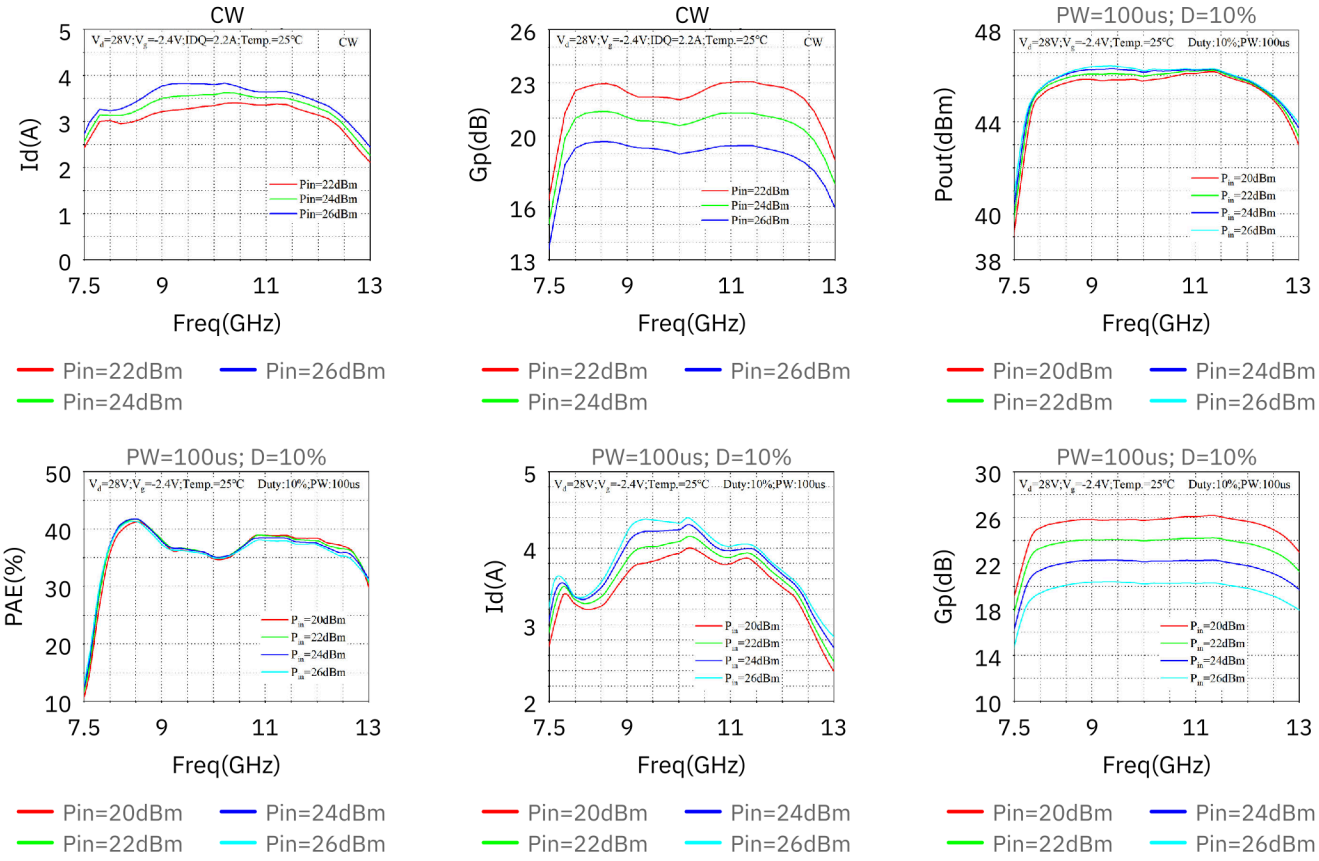












出力電力、電力付加効率、ドレイン電流、電力利得。 Vd = 28 V; Vg = -2.4 V; TA = 25 °C. 図1–2：CW; IDQ = 2.2 A; Pin = 22/24/26 dBm。 図3–6：PW = 100 µs; D = 10%; Pin = 20/22/24/26 dBm。

文書に関する注意

仕様は製品の更新に伴い改訂される場合があります。設計を確定する前に、現行の文書改訂版と製品固有の要件を LCRF に確認してください。供給構成は承認済みの見積書および注文書類で定義されます。